

**СПИСОК**  
научных и учебно-методических работ

Турин Валентин Олегович

Общее количество трудов до 01.07.2011 г. 59, из них:  
научных работ – 59;  
учебно-методических работ – 0

**Работы, опубликованные в период с 01.07.2011 г. по настоящее время**

№ п/п	Наименование работы, ее вид	Форма работы	Выходные данные	Объем в с.	Соавторы
1.	Корректный учет ненулевой дифференциальной проводимости в режиме насыщения в компактной модели полевого нанотранзистора (статья)	печатная	Наноинженерия, 8, С. 41-48, 2011	<u>8</u> 7	Турин В.О., Зебрев Г.И., Инигез Б., Шур М.С.
2.	Моделирование полевых транзисторов на основе нитрида галлия (отчет)	печатная	Грант РФФИ № 09-02-97543, (2011).	<u>69</u> 59	Турин В.О., Седов А.В., Кизилова Н.В., Зебрев Г.И., Дорофеев А.А.
3.	Physics-based compact modeling of double-gate graphene field-effect transistor operation (статья)	печатная	28th International Conference on Microelectronics (MIEL) Proceedings. Pp. 237-240. 2012	<u>4</u> 0,2	Zebrev G., Tselykovskiy A., Turin V.
4.	Моделирование стойкости мощных полевых транзисторах к микродозовым и SEGR эффектам при воздействии тяжелых заряженных частиц космического пространства. (тезисы)	печатная	Научная сессия НИЯУ МИФИ-2013, г. Москва. 1 февраля 2013. Аннотации докладов. Том I. С. 128.	<u>0,2</u> 0,02	Усейнов. Р.Г., Зебрев Г. И., Вагуев А.С., Емельянов В.В., Турин В.О.
5.	Реализация компактной модели МОП-транзистора	печатная	Научная сессия НИЯУ МИФИ-2013,	<u>0,2</u> 0,02	Турин В.О., Студенников А.С.,

	корректным учетом дифференциальной проводимости в режиме насыщения на языке Verilog-A в САПР Symica (тезисы)		г. Москва. 1 февраля 2013. Аннотации докладов. Том I. С. 128.		Гостенков Е.В., Цырлов А.М., Зебрев Г.И., Инигез Б., Шур М.С.
6.	Влияние времени рассеяния носителей заряда на квантовой яме ДГС лазеров на их оптико-электрические характеристики (статья)	печатная	Энерго- и ресурсосбережение - XXI век. Материалы XI международной научно-практической интернет-конференции. - г. Орёл : Госуниверситет - УНПК, 2013. - С. 234-236.	$\frac{3}{0,3}$	Козил З., Турин В.О., Будулева Е.А.
7.	Модель нелинейного резистора - вертикальной части стока ДМОП-транзистора (статья)	печатная	Энерго- и ресурсосбережение - XXI век. Материалы XI международной научно-практической интернет-конференции.- г. Орёл : Госуниверситет - УНПК, 2013. - С. 231-234.	$\frac{4}{3}$	Гостенков Е.В., Турин В.О., Ващенко В.А.
8.	Microdose Induced Drain Leakage Effects in Power Trench MOSFETs: Experiment and Modeling (тезисы)	печатная	Radiation Effects on Components and Systems 2013 (RADECS 2013). Conference Program. P. 33	$\frac{0,02}{0,001}$	Zebrev G.I., Vatuev A.S., Emeliyanov V.V., Anashin V.S., Gorbunov M.S., Turin V.O., Useinov R.G.
9.	The Correct Account of Nonzero Differential Conductance in the Saturation Regime in the MOSFET Compact Model (тезисы)	компьютерная	ESSDERC-ESSCIRC 2013. Workshop «MOS-AK Compact Modeling». - Bucharest, 2013	$\frac{7}{5}$	Turin V.O., Zebrev G. I., Makarov S.V., Iniguez B., Shur M.S.
10.	TCAD - Educational and Research Lab. in micro- and noelectronics (тезисы)	компьютерная	ESSDERC-ESSCIRC 2013. Workshop «Potential of Eastern European Countries in	$\frac{5}{5}$	Turin V.O.

			Key Enabling Technologies». - Bucharest, 2013.		
11.	Моделирование кремниевого вертикального МОП-транзистора с двойной диффузией на Verilog-A в САПР Symica (статья)	печатная, компьютерная	17-ая Международная телекоммуникационная конференция молодых ученых и студентов «Молодежь и наука». - г. Москва: НИЯУ МИФИ, 2013	<u>2</u> 1,5	Студенников А.С., Гостенков Е. В., Турин В.О.
12.	Модель нелинейного резистора вертикальной части стока ДМОП-транзистора (статья)	компьютерная	17-ая Международная телекоммуникационная конференция молодых ученых и студентов «Молодежь и наука». - г. Москва: НИЯУ МИФИ, 2013	<u>2</u> 1,5	Гостенков Е.В., Студенников А.С., Турин В.О.
13.	Моделирование мощных биполярных транзисторов после облучения быстрыми нейтронами в САПР Synopsys TCAD (тезисы)	печатная	Сборник аннотаций докладов XVIII Международной научно-технической конференции и Российской научной школы молодых ученых и специалистов «Инноватика – 2013». - г. Москва: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2014.	<u>0,2</u> 0,05	Поярков В.Н., Кшенский О.Н., Турин В.О.
14.	The correct account of nonzero differential conductance in the saturation regime in the MOSFET compact model (статья)	печатная	International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields. Special Issue - Modeling of high-frequency Silicon transistors. 2014. Pp. 1192-1204	<u>12</u> 9	Turin V.O., Zebrev G.I., Makarov S.V., Iniguez B., Shur M.S.

15.	Приборно-технологическое моделирование влияния деградации времени жизни носителей на распределение тока в структуре мощного биполярного транзистора (тезисы)	печатная	Научная сессия НИЯУ МИФИ-2014, г. Москва. 29 января 2014. Аннотации докладов. Том I. С. 58.	0,2 0,15	Турин В.О., Кильчицкая М.В., Герасимов К.А.
16.	Моделирование мощных биполярных транзисторов после облучения быстрыми нейтронами в САПР Synopsys TCAD (статья)	печатная	Материалы XVIII Международной научно-технической конференции и Российской научной школы молодых ученых и специалистов «Инноватика – 2013». - г. Москва: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2014 (принята в печать).	15 4	Поярков В.Н., Кшенский О.Н., Турин В.О.
17.	Microdose Induced Drain Leakage Effects in Power Trench MOSFETs: Experiment and Modeling (статья)	печатная	IEEE Transactions on Nuclear Science, Special Issue: Proceeding of: RADECS 2013 (Aug. 2014) (принята в печать)	5 0,5	Zebrev G.I., Vatuev A.S., Useinov R.G., Emel'yanov V.V., Anashin V.S., Gorbunov M.S., Turin V.O., Yesenkov K.A.

Соискатель



В.О. Турин

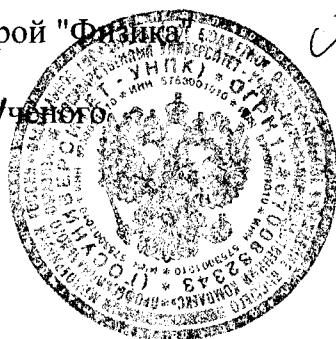
Список верен:

Заведующий кафедрой "Физика"



В.О. Турин

Ученый секретарь Ученого  
Совета




К.В. Подмастерьев

22 апреля 2014 г.